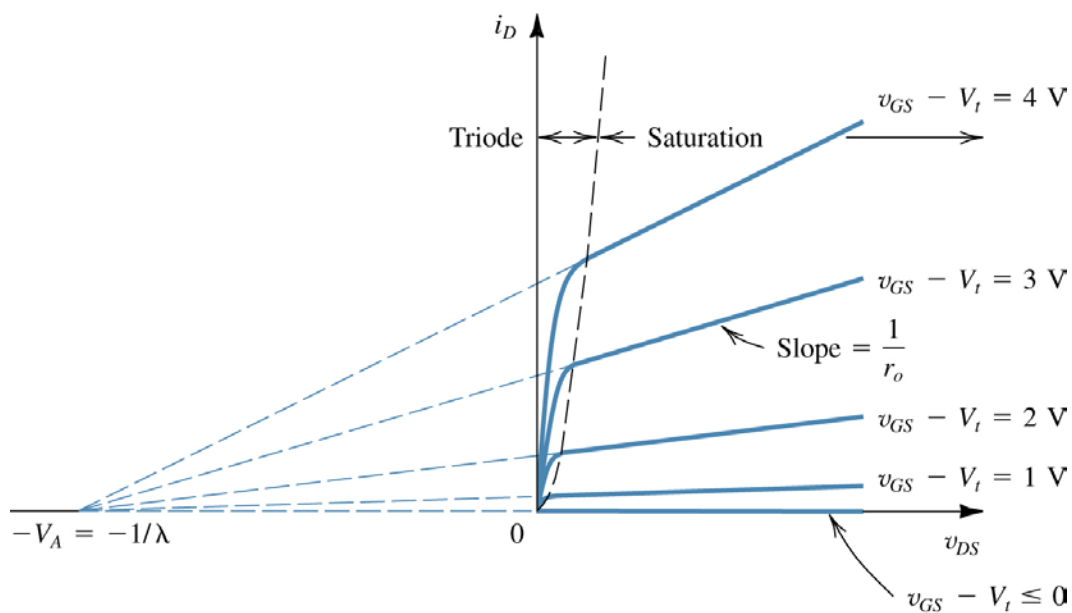


All'aumentare di V_{DS} oltre il valore di saturazione $V_{DS\text{ SAT}}$ la posizione del *pinch-off* nel canale si allontana dal *drain*, determinando così la diminuzione della lunghezza effettiva del canale di una quantità ΔL .



Variazione di I_D con V_{DS} nella regione di saturazione. Il parametro V_A del MOSFET è compreso generalmente nell'intervallo tra 30 V e 200 V.